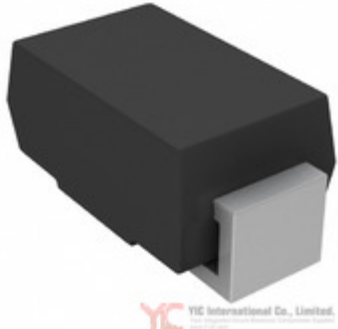



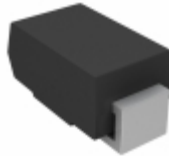
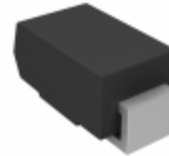

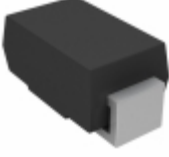
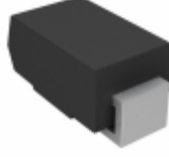


	<h2 style="color: red;">US1GHE3_A/I</h2>
	Hersteller-Teilenummer: US1GHE3_A/I
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC
	Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.US1GHE3_A/I.pdf  2.US1GHE3_A/I.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	US1GHE3_A/I
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 1A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	400V
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AC (SMA)
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	50ns
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	DO-214AC, SMA
Andere Namen	US1GHE3_A/IGICT
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 400V 1A Surface Mount DO-214AC
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 400V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	15pF @ 4V, 1MHz
Basisteilenummer	US1G

US1GHE3_A/I Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, US1GHE3_A/I-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, US1GHE3_A/I Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ US1GHE3_A/I E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>US1GHR3G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC</p>	 <p>US1GHE3_A/I Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC</p>	 <p>US1GHE3/61T Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC</p>	 <p>US1GHE3/61 TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC</p>
 <p>US1GHE3/61T Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC</p>	 <p>US1GHE3_A/H Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 400V 1A DO214AC</p>	 <p>US1GL PHY US1GL PHY</p>	 <p>US1GHE3/61 VISHAY US1GHE3/61 VISHAY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

US1GHE3_A/I Electro-Films (EFI) / Vishay	US1GHE3_A/I Datenblatt	US1GHE3_A/I-Datenblätter	US1GHE3_A/I PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
US1GHE3_A/I Electronic	US1GHE3_A/I-Komponenten	US1GHE3_A/I-Verteiler	US1GHE3_A/I-Bild	US1GHE3_A/I-Teil
US1GHE3_A/I Preis	US1GHE3_A/I Hersteller	US1GHE3_A/I Bild	US1GHE3_A/I Aktie	US1GHE3_A/I Inventar
US1GHE3_A/I Neu	US1GHE3_A/I Original	US1GHE3_A/I garantiert	US1GHE3_A/I RFQ	US1GHE3_A/I Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited